



ハイパワーデバイス用材料市場の現状と展望 SiC/GaN/Ga₂O₃/AlN他 調査分析レポート2026年5月19日提供開始

高性能の材料技術開発と事業化に関する活動を行う一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所（事務局：東京都港区、代表理事：瀧田理康、以下、高材研）は、調査分析レポート『ハイパワーデバイス用材料市場の現状と展望 SiC/GaN/Ga₂O₃/AlN他』を2026年5月19日に提供開始します。

調査レポート企画趣旨：

ハイパワーデバイス用材料市場は、現在自動車用/エコカー用や次世代通信用（5G～6.8G）などに実用が進み、量産化へと拡大中である。ウエハー形状も大型化が進み、低コスト化が可能になってきた。主な材料としていち早く量産化が進んだSiCウエハー市場（ベア基板、チップ）、実用/拡大化が進んでいるGaNウエハー市場（ベア基板、チップ）、Ga₂O₃市場（ベア基板、チップ）、次世代材料（AlN、ダイヤモンド等）など、多くの企業が参入している。

EV市場の市場性が不安視されてきたことから量産化が進んでいるSiCウエハーの伸びが鈍化しつつある一方、産業機械用、車両用、エコエネルギー用ほか、新規用途開拓が期待される。次世代通信用を主力としたGaN市場の大幅な伸びや、Ga₂O₃や次世代ハイパワー材料が台頭し競争が激化することなどが予想される。

本調査はこうしたハイパワーデバイス用材料市場の現状を独自に調査、分析した調査資料です。

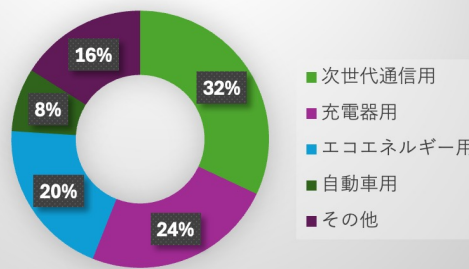
【調査資料概要】

調査期間：2026年3～5月
体裁：A4版タテ、約100ページ
レポート価格：380,000円（税込：418,000円）

【ご購入に関するお問合せ】

調査項目の確認、サンプルページ等については
販売事務局（prc@argo-ms.com（株）アルゴバース内）で承ります。

GaN応用市場（用途別）



（法人概要）

一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所 設立：2024年9月27日 代表理事：瀧田 理康
事務所：〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F
URL：<https://amc-labo.com>

本件に関するお問い合わせ

高材研 広報事務局 メール：amc-labo.info@amc-labo.com 電話：03-3798-2172